

Silicon Diode

BAQ35

125V / 200mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

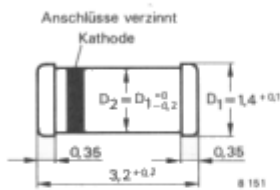
BAQ 33...BAQ 35**Silizium-Planar-Dioden**

Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzögerungsschaltungen

Besondere Merkmale:

- Sehr niedriger Sperrstrom

Abmessungen in mm



Glasgehäuse
SOD 80
Mini MELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung	BAQ 33	U_R	30	V
	BAQ 34	U_R	60	V
	BAQ 35	U_R	125	V
Stoßdurchlaßstrom				
$t_p = 1 \mu s$		I_{FSM}	2	A
Durchlaßstrom		I_F	200	mA
Sperrschichttemperatur		T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich		T_{stg}	- 65....+ 200	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschichttemperatur auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm		R_{thJA}	500	K/W
---	--	------------	-----	-----

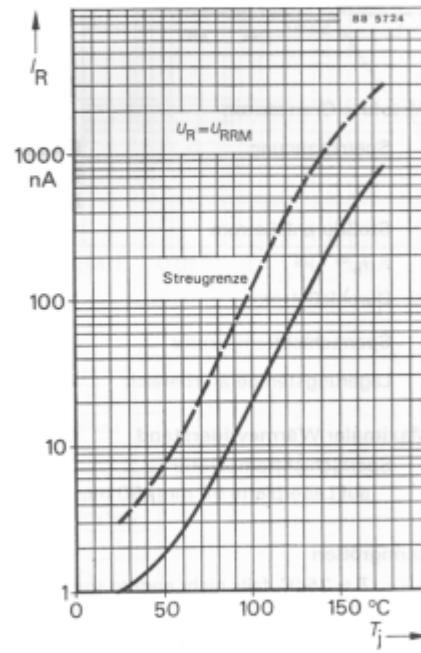
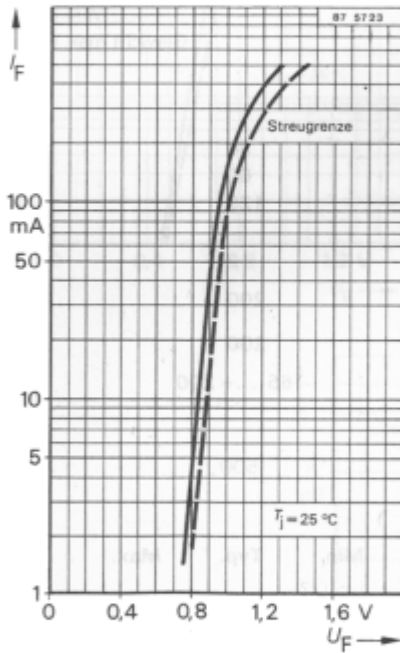
Kenngößen

$T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung					
$I_F = 100 \text{ mA}$				1	V
Sperrstrom					
$E^{(1)} \leq 500 \text{ lx}$, U_R					
$U_R, T_j = 125 \text{ °C}$			1	3	nA
$U_R = 15 \text{ V}$	BAQ 33			0.5	1
$U_R = 30 \text{ V}$	BAQ 34			0.5	1
$U_R = 60 \text{ V}$	BAQ 35			0.5	1

BAQ 33...BAQ 35

			Min.	Typ.	Max.	
Durchbruchspannung $I_R = 5 \mu\text{A}$	BAQ 33	$U_{(BR)}^{1)}$	40			V
	BAQ 34	$U_{(BR)}^{1)}$	70			V
	BAQ 35	$U_{(BR)}^{1)}$	140			V
Diodenkapazität $V_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$		C_D			3	pF



¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0.01, t_p = 0.3 \text{ ms}$